

关键指标

频率: 6~18GHz

增益: 20dB

1dB 压缩点输出功率: 21dBm

3dB 压缩点输出功率: 21.5dBm

电压/静态电流: +5V/115mA

芯片尺寸: 1.6mm×0.8mm

产品简介

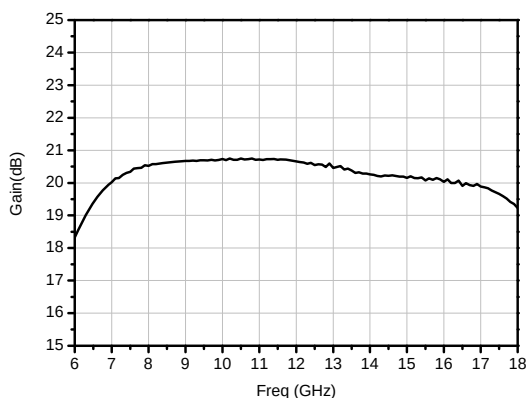
HG126FC 驱动放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 单电源供电, 静态电流为 115mA, 输入输出端均集成有隔直电容。

电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=+5\text{V}$)

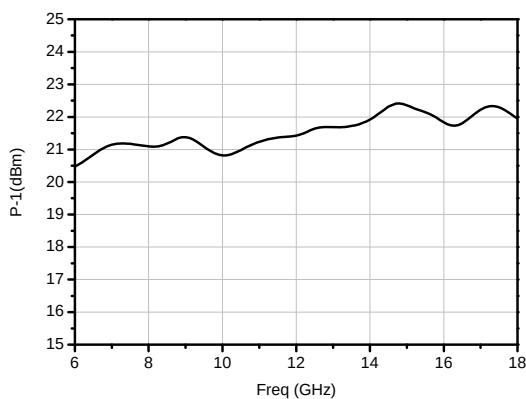
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~18		
增益(dB)	-	20	-
增益平坦度(dB)	-	±1	-
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.4	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	21	-
3dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	21.5	-
静态电流 (mA)	-	115	-

典型测试曲线

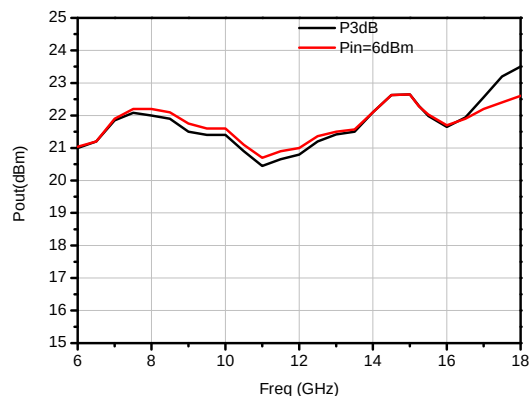
增益



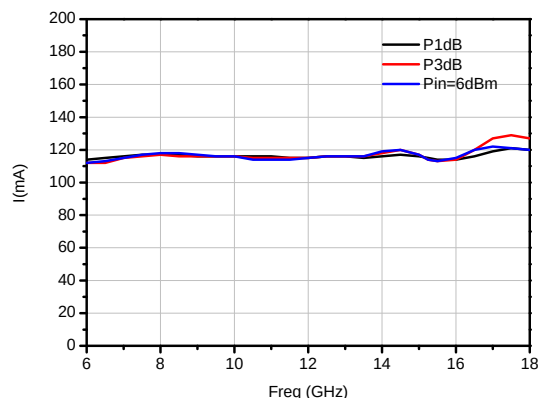
1dB 压缩点输出功率



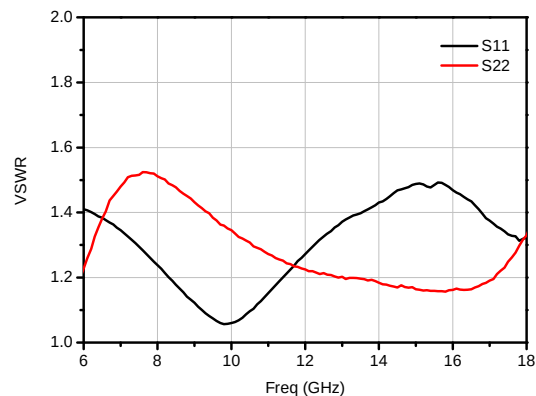
输出功率



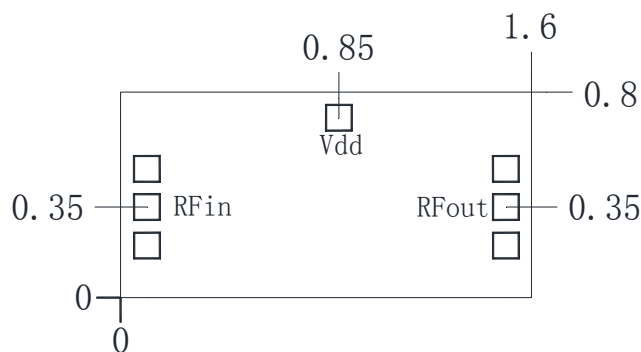
动态电流



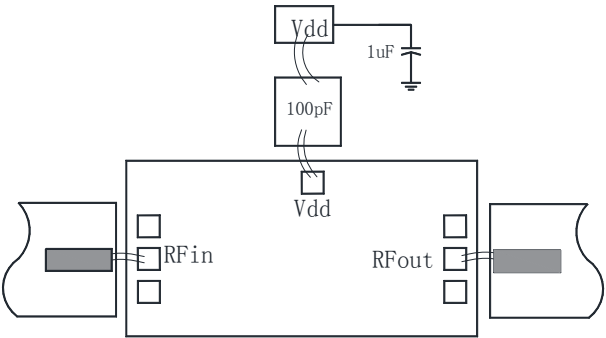
端口驻波



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
- 2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
- 5. 芯片微波端有隔直电容；
- 6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。